

200mm Silicon Wafer Specification

Spec No.(编号) : 8PB0H1030A0

Revision(版本号) : A0

编制人 : 边永智

审核 : 宁永铎

编制日期 : 2022/12/15

序号 : GK/CGPG-2219

Characteristics 参数		Unit (单位)	Secification Value (规范值)	Remarks (备注)
材料	Material		polished Wafer	
等级	Grade		Prime	
生长方法	Crystal Growth Method		CZ	
导电类型	Conductivity Type		P	
掺杂剂	Dopant		Boron	
电阻率	Resitivity	Ω·cm	10-30	*
电阻率径向均匀性	RRV-max	%	/	
氧含量	Oxygen Concerntation	ppma	/	
氧径向变化	ORV-max	%	/	
碳含量	Carbon Concerntation	ppma	/	
少子寿命	Lifetime	μs	/	
体金属沾污	Bulk Metal Contamination	at/cm ³	/	
位错密度	Dislocation Density	ea/cm ²	None	
微缺陷密度	OISF	ea/cm ²	None	
晶体原生颗粒	COP	ea/wafer	/	
漩涡	Swirl		/	
滑移线	Slip		/	
晶向及晶向偏移度	Crystal Orientation	°	<100>0±1.0	*
主参考面位置	Primary Notch Location	°	<110>±1.0	*
主参考面长度	Primary Notch Length	mm	1-1.25 ; 89-95 °	*
副参考面位置	Secondary Flat Location	°	None	
副参考面长度	Secondary Flat Length	mm	None	
直径	Diameter	mm	200±0.2	*
倒角	Edge Contour	°	22° ; R=0.31; Symmetric	*
厚度及公差	Thickness	μm	725 ± 15	*
TTV	TTV	μm	<4	*
BOW	BOW	μm	<30	*
WARP	WARP	μm	<30	*
STIR	SFQR	μm	/	
激光刻字	Laser Mark		/	
正表面	Front Surface		polished	
背表面	Backside Surface		Acid etched	
背表面工艺	Backside POLY	A	/	
背表面工艺	Backside LTO	A	/	
背表面粗糙度	Backside roughness	um	/	
背表面光泽度	Backside gloss	GU	/	
边缘抛光	Edge polishing		Yes	
表面颗粒	Light Point Defects	ea/wafer	≤50(≥0.12um); ≤30(≥0.16um) ; ≤15(≥0.2um)	*
表面金属	Front Surface Chemistry		<1E10(Al Cr Fe Ni Cu Zn Ti Na Ca K Co)	*

